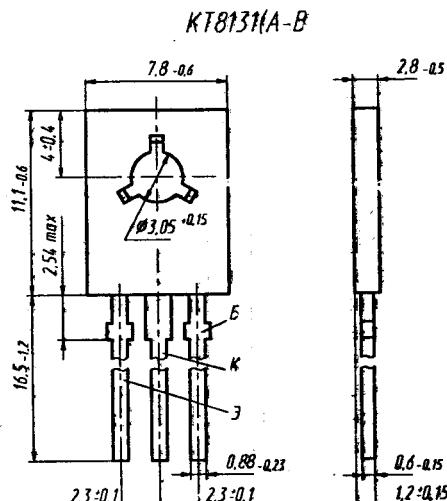


KT8131А, KT8131Б, KT8131В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-p-n* составные усиительные. Предназначены для применения в низкочастотных усилителях мощности и ключевых схемах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{KB} = 3$ В, $I_3 = 2$ А 750...15000

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{KB} = 10$ В, $I_3 = 0,75$ А,
не менее 25 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 0,1$ А,
не менее:

KT8131А 40 В

KT8131Б 60 В

KT8131В 80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер
при $I_K = 2$ А, $I_E = 8$ мА, не более 2 В

Напряжение насыщения база—эмиттер
при $I_K = 2$ А, $I_E = 8$ мА, не более 4 В

Емкость коллекторного перехода	
при $U_{KB} = 10$ В, не более	100 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = U_{KB, MAX}$, не более	100 мкА
Обратный ток коллектор—эмиттер	
при $U_{KE} = U_{KE, MAX}$, $R_{B3} = 1$ кОм, не более	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{B3} = 5$ В, не более	2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

KT8131A	40 В
KT8131Б	60 В
KT8131В	80 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер

при $R_{B3} = 1$ кОм:

KT8131A	40 В
KT8131Б	60 В
KT8131В	80 В

Постоянное напряжение эмиттер—база..... 5 В

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-
тора при $T_K = -45 \dots +25$ °С:

с теплоотводом ¹	20 Вт
без теплоотвода ²	1 Вт

Температура $p-n$ перехода

Температура окружающей среды

$= -45 \dots T_K =$

$= +85$ °С

¹ При $T_K > +25$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом снижается линейно на 0,16 Вт/°С.

² При $T_K > +25$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода снижается линейно на 8 мВт/°С.

Транзисторы являются комплементарными с транзисторами KT8130A—KT8130B.